广州金永利电子有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

13005A

A1

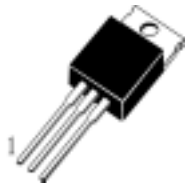
对应国外型号
3DD13005A

■ 主要用途

高压快速开关

■ 外形图及引脚排列

TO-220



1—基 极，B
2—集电极，C
3—发射极，E

■ 极限值（T_a=25℃）

T_{stg}——贮存温度…… -55~150℃

T_j——结温…… 150℃

P_C——集电极功率耗散（T_c=25℃）…… 70W

V_{CBO}——集电极—基极电压…… 700V

V_{CEO}——集电极—发射极电压…… 400V

V_{EBO}——发射极—基极电压…… 9V

I_C——集电极电流（DC）…… 4A

I_C——集电极电流（脉冲）…… 8A

I_B——基极电流…… 2A

■ 电参数（T_a=25℃）

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
$BV_{CEO(sus)}$	集电极—发射极维持电压*	400			V	I_C=10mA, I_B=0
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			1	mA	V_{EB}=9V, I_C=0
h_{FE}	直流电流增益*	10		40		V_{CE}=5V, I_C=1A
		8		40		V_{CE}=5V, I_C=2A
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压*			0.5	V	I_C=1A, I_B=0.2A
				0.6	v	I_C=2A, I_B=0.5A
				1	V	I_C=4A, I_B=1A
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压*			1.2	V	I_C=1A, I_B=0.2A
				1.6	V	I_C=2A, I_B=0.5A
C_{ob}	共基极输出电容		65		pF	V_{CB}=10V, f=0.1MHz
f_T	特征频率	4			MHz	V_{CE}=10V, I_C=0.5A
t_{on}	导通时间			0.8	μs	
t_s	载流子贮存时间			4	μs	V_{CC}=125V, I_C=2A,
t_f	下降时间			0.9	μs	I_{B1}=-I_{B2}=0.4A

分档：H1（10--16） H2（14--21） H3（19--26） H4（24--31） H5（29--40）